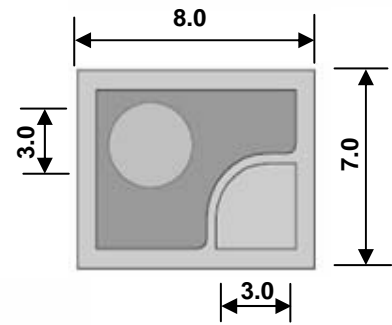




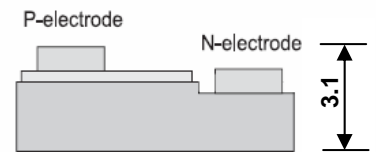
◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性



◆ 物理参数:

P 电极	金
N 电极	金
芯片尺寸	8.0mil × 7.0mil (203 ± 15μm × 178 ± 15μm)
芯片厚度	3.1mil (80 ± 15μm)
焊盘尺寸	3.0mil (75 ± 10μm) in diameter



单位: mil

◆ 光电参数: (Tc=22℃, I_F=20mA)

产品型号	波长均值范围 (WLD, nm)	正向电压均值范围 (V _F , V)	光强均值范围 (I _V , mcd)
S-08ABAU*	450~475	3.0~3.6	30~100

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下样测试
- 芯片封装工艺最高温度低于 280℃, 持续时间小于 10 秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ± 1.0nm
- 可根据客户需要订做特殊规格的芯片